

**パク ビョンウンさん / 東京工業大学**  
**Dr. Byung Eun Park / Tokyo Institute of Technology**

<外国人研究者 プロフィール Profile>

国籍: Nationality:	韓国 / Korea
日本留学時の滞在期間: Period of Stay During Studying in Japan:	1995年 9月～1999年 3月 Sep, 1995 – Mar, 1999
日本留学時の大学: Educational Background In Japan:	東京工業大学総合理工学研究科(博士課程) Tokyo Institute of Technology
専攻分野: Major Field:	電子システム Semiconductor device
現在の所属/職位: Present Institution/ Status:	ソウル市立大学准教授 University of Seoul/Associate Professor



<研究報告 Follow up Research Fellowship>

受入研究者氏名: Research Adviser:	石原 宏 教授 / Professor Hiroshi Ishiwara
受入れ期間: Researching Period:	2010.6.25 – 2010.8.29 (66日) Jun 26, 2010 – Aug 29, 2010
研究課題: Theme of Research:	Study on Organic Ferroelectric Device

パク ビョンウンさん  
Dr. Byung Eun Park

■ 研究概要 Outline of Research

強誘電体メモリー (FeRAM : ferroelectric random access memory) は、この 自発分極の方向をバイナリ情報の“0”と“1”とに対応させるため、電源を切っても記憶内容が消えない(不揮発性)特徴がある。しかし、強誘電体メモリーの高集積化に関しては必ずしも十分な見通しが得られているとはいえず、革新的な強誘電体材料や新しい回路構成の出現が待たれている。強誘電体メモリーの高集積化のためには革新的な新規強誘電体材料が必要不可欠であるという問題意識を強くもっている。そのため、最近特に、高分子(弗化ビニリデン・三弗化ビニリデン共重合体:PVDF-TrFE)の有機材料を有望な高性能材料として注目し、その物性と薄膜作製について研究している。



日韓強誘電体学会(No.1)  
Japan-Korea Conference on Ferroelectrics(No1)

■ 研究成果 Result of Research



日韓強誘電体学会(No.3)  
Japan-Korea Conference on Ferroelectrics(No3)

有機強誘電体である PVDF-TrFE 薄膜及び有機半導体である P3HT 薄膜をゾルーゲル法を用いて作製し電気的特性の評価を行った結果、良好な特性を得られた。また、有機強誘電体膜及び有機半導体の薄膜作製条件を確立した。その条件のもとにフレキシブル基板上に有機強誘電体トランジスタを作製し、電気的特性を確認した。

## ■日本留学の思い出 Memories of Studying in Japan

「10年あれば山河も変わる」ということわざがありますが、95年以来10年間、日本の大学(東京工業大学)に身を置いた小生としても、金大中大統領在任時代から、多くの韓国人が日本の大学に入学するなど、活発な人的交流が続いていることを肌で感じています。今後も日韓友好のかけがえのない場として、政治、経済、社会文化的な側面だけでなく、技術、ヒューマンリソースの交流の場として、留学の経験を生かして、ますますの飛躍をするように全力を尽くす予定で御座います。



日韓強誘電体学会(No.4)

Japan-Korea Conference on Ferroelectrics(No.4)